



华晶分立器件

3DD128F

低频放大管壳额定双极型晶体管

1 概述与特点

3DD128F 主要用于低压电子镇流器中作功率开关，是电子镇流器的核心器件。该产品采用了一种特殊结构，巧妙地将二极管直接设计集成在 E、C 极之间，既简化了外围线路，节省了应用成本，又提高了产品的可靠性。其特点如下：

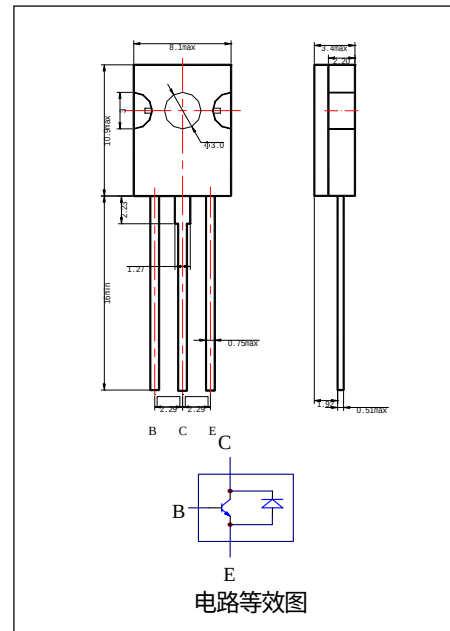
- 击穿电压高、漏电流小
- 开关速度快
- 饱和压降低
- 电流特性好
- 封装形式：TO-126F

2 电特性

2.1 极限值

除非另有规定， $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参 数 名 称	符 号	额 定 值	单 位
集电极-发射极电压	V_{CE0}	200	V
集电极-基 极电压	V_{CB0}	350	V
发射极-基 极电压	V_{EB0}	9	V
集电极电流	I_C	4	A
耗散功率($T_a=25^{\circ}\text{C}$)	P_C	1.5	W
($T_c=25^{\circ}\text{C}$)		50	
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度	T_{stg}	$-55\sim+150$	$^{\circ}\text{C}$



2.2 电参数 除非另有规定， $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件	规 范 值			单 位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	I_{CB0}	$V_{CB}=350\text{V}, I_E=0$			1	mA
发射极-基极截止电流	I_{EB0}	$V_{EB}=9\text{V}, I_C=0$			1	mA
共发射极正向电流传输比的静态值	h_{FE}^a	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=0.5\text{A}$	10		40	
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE\text{ sat}}^a$	$I_C=2\text{A}, I_B=0.5\text{A}$			1	V
基 极-发射极饱和电压	$V_{BE\text{ sat}}^a$	$I_C=2\text{A}, I_B=0.5\text{A}$			1.5	V
下降时间	t_f	$V_{CC}=120\text{V}, I_C=2\text{A}$			0.8	μs
贮存时间	t_s	$2I_{B1}=-I_{B2}=0.4\text{A}$			3.6	μs
特征频率	f_T	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=500\text{mA}$ $f=1\text{MHz}$	4			MHz

a: 脉冲测试 $t_p \leq 300 \mu\text{s}$, $\delta \leq 2\%$

无锡华晶微电子股份有限公司

地址: 江苏省无锡市梁溪路 14 号 电话: (0510)5807228-2268、2299 传真: (0510)5800360

3 特性曲线

